

	<h2>SI7900AEDN-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7900AEDN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7900AEDN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 29962 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7900AEDN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	29962 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Common Drain 20V
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.5W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 8.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI7900
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7900AEDN-T1-GE3TR

SI7900AEDN-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7900AEDN-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7900AEDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7900AEDN-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7900EDN VISHAY SI7900EDN VISHAY</p>	 <p>SI7900EDM VISHAY VISHAY DFN</p>	 <p>SI7900AEDN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 6A 1212-8</p>	 <p>SI7900AEDA-T1-E3 VISHAY VISHAY VSSOP-8</p>
 <p>SI7900AEDN SI SI7900AEDN SI</p>	 <p>SI7900AEDN-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 6A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7900AEDN-T1 VISHAY SI7900AEDN-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7900DN VISHAY VISHAY QFN-8</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ SI7888DP-T1-E3 ⊖ SI7892ADP-T1-GE3 ⊕ SI7892BDP-T1-GE3 D SI7898DP ⇒ SI7900ADN ⇒ SI7900AEDN-T1-GE3 ⊕ SI7901EDN-T1 ⊖ SI7904BDN-T1-GE3 ⊕ SI7904DN-T1-E3 ⇒ SI7909DN-T1-E3 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7888DP-T1-E3 ⊕ SI7892ADP-T1-GE3. ⊖ SI7892DP ⊕ SI7898DP-T1-E3 ⇒ SI7900AEDN ⇒ SI7900EDN D SI7901EDN-T1-E3 ⊕ SI7904BDN-T1-GE3 ⊖ SI7904DN-T1-GE3 ⊕ SI7909DN-T1-E3 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7888DP-T1-GE3 D SI7892BDP-T1-E3 ⊕ SI7892DP-T1 ⊖ SI7898DP-T1-E3 ⊕ SI7900AEDN-T1 D SI7900EDN-T1 ⇒ SI7901EDN-T1-E3 ⇒ SI7904DN ⊕ SI7904DN-T1-GE3 ⊖ SI7909DN-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> D SI7888DP-T1-GE3 ⇒ SI7892BDP-T1-E3 ⇒ SI7892DP-T1-E3 ⊕ SI7898DP-T1-GE3 ⊖ SI7900AEDN-T1-E3 ⊕ SI7900EDN-T1-E3 ⇒ SI7904BDN-T1-E3 ⇒ SI7904DN-T1 D SI7905DN-T1-GE3 ⊕ SI7909DN-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7892ADP-T1-E3 ⇒ SI7892BDP-T1-GE3 ⇒ SI7892DP-T1-GE3 ⇒ SI7898DP-T1-GE3 ⇒ SI7900AEDN-T1-E3 ⊖ SI7900EDN-T1-GE3 ⇒ SI7904BDN-T1-E3 ⇒ SI7904DN-T1-E3 ⇒ SI7905DN-T1-GE3 ⇒ SI7911DN
--	--	---	--	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited